5.1. Назначение

Микросхема 5503XM1-289 (далее по тексту просто «микросхема») предназначена для построения однонаправленных информационных каналов с трансформаторной развязкой. Рекомендуемая область применения — гальванически развязанное управление периферийным оборудованием.

5.2. Общие сведения

Микросхема выполнена по радиационно стойкой технологии, разрешена для применения в специальной аппаратуре и обладает следующими возможностями:

- Напряжение питания 5B±10%.
- 8 самостоятельных каналов с общим сбросом.
- Генератор с заданием частоты внешним конденсатором.

Микросхема в каждом канале имеет драйвер первичной обмотки трансформатора развязки, управляющий одним или двумя мощными полевыми транзисторами, подключенными к его вторичным обмоткам.

5.2.1. Условное графическое обозначение микросхемы

На рис. 5-1 приведено рекомендуемое условное графическое изображение микросхемы.

24	D0	A0	23
-	D0		22
25		B0	21
	D1	A1	20
26	D0	B1	19
	D2	A2	18
27	D0	B2	17
	D3	A3	16
02	L .	B3	12
	D4	A4	13
03	D	B4	10
-	D5	A5	11
04	D0	B5	08
	D6	A6	09
05	D7	B6	06
	D7	A7	07
01		B7	28
15	CLR	Vdd	14
	FREQ	GND	

Рис. 5-1. Условное графическое изображение микросхемы

Официальное обозначение: микросхема 5503ХМ1-289 АЕЯР.431260.159 ТУ.

5.2.2. Назначение выводов

В табл. 5-1 приведено краткое описание выводов микросхемы.

Таблица 5-1. Описание выводов микросхемы (часть 1 из 2)

Номер	Имя	Тип	Буфер	Описание
1	CLR	DI		Вход блокировки низким уровнем
2	D4	DI		Вход данных 4-го канала
3	D5	DI		Вход данных 5-го канала
4	D6	DI		Вход данных 6-го канала
5	D7	DI		Вход данных 7-го канала
6	A7	DO	CMOS	Выход А 7-го канала
7	B7	DO	CMOS	Выход В 7-го канала

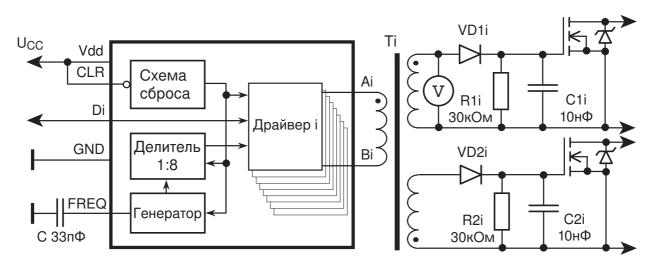
Таблица 5-1. Описание выводов микросхемы (часть 2 из 2)

Номер	Имя	Тип	Буфер	Описание
8	A6	DO	CMOS	Выход А 6-го канала
9	B6	DO	CMOS	Выход В 6-го канала
10	A 5	DO	CMOS	Выход А 5-го канала
11	B5	DO	CMOS	Выход В 5-го канала
12	A4	DO	CMOS	Выход А 4-го канала
13	B4	DO	CMOS	Выход В 4-го канала
14	GND	Р		Вывод подключения «минуса» (общего провода) источника питания
15	FREQ			Вывод для подключения внешнего конденсатора
16	В3	DO	CMOS	Выход В 3-го канала
17	A3	DO	CMOS	Выход А 3-го канала
18	B2	DO	CMOS	Выход В 2-го канала
19	A2	DO	CMOS	Выход А 2-го канала
20	B1	DO	CMOS	Выход В 1-го канала
21	A1	DO	CMOS	Выход А 1-го канала
22	В0	DO	CMOS	Выход В 0-го канала
23	A0	DO	CMOS	Выход А 0-го канала
24	D0	DI		Вход данных 0-го канала
25	D1	DI		Вход данных 1-го канала
26	D2	DI		Вход данных 2-го канала
27	D3	DI		Вход данных 3-го канала
28	Vdd	Р		Вывод подключения «плюса» источника питания

Условные обозначения в таблице: CMOS — КМОП; DI, DO — цифровой вход и выход, Р — питание.

5.2.3. Рекомендуемая схема включения

Пример реализации одного канала передачи с трансформаторной развязкой приведен на рис. 5-2.



Примечания к рисунку: С — конденсатор, определяющий частоту работы внутреннего генератора (в данном примере 1,6МГц); Ті — трансформатор из блока импульсных трансформаторов БТИ9-187В; VD1i,VD2i — диоды из состава диодной матрицы 2ДС627А.

Рис. 5-2. Внутренняя структура микросхемы и пример включения

5.2.4. Работа микросхемы

В состав микросхемы входят следующие узлы:

- 8 драйверов с входами данных Di и с противофазными выходами Ai и Bi.
- Узел сброса с входом управления CLR.
- Генератор с выводом FREQ для подключения внешнего конденсатора.
- Счетчик-делитель на 8.

Узел сброса при подаче на вход CLR низкого уровня блокирует работу микросхемы и переводит выходы драйверов в отключенное (высокоимпедансное) состояние. Для нормальной работы микросхемы на вход CLR должен быть подан высокий уровень.

Генератор вырабатывает внутреннюю тактовую частоту в пределах 200...2000 кГц в зависимости от номинала подключенного к выводу FREQ внешнего конденсатора. Делитель понижает частоту генератора до 25...250 кГц и именно сигнал этой частоты появляется на выходах драйверов.

Драйверы формируют на выходах Аі и Ві состояние низкого логического уровня, если на вход Di подаётся низкий уровень. При подаче высокого уровня (Di=1) и в зависимости от момента появления высокого уровня этого сигнала через Т...4*Т (здесь Т — период частоты тактового генератора) сигналы на выходах Аі и Ві становятся противофазными. При повторной смене уровня сигнала на входе (Di=0) оба выхода Аі и Ві переходят в состояние низкого уровня также по истечение времени Т...4*Т в зависимости от момента появления низкого уровня сигнала. Временная диаграмма сигналов на выводах микросхемы приведена на рис. 5-3.

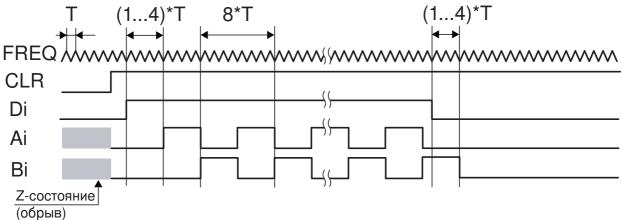


Рис. 5-3. Временная диаграмма работы канала микросхемы

Схемотехническая реализация драйверов исключает протекание сквозных токов в моменты переключения выходов Аі и Ві.

Входы Di не имеют верхнего защитного диода, что позволяет подавать на эти входы напряжение высокого уровня (но не более 5,5 В) при отключенном питании микросхемы.

Допускается монтажное объединение одноименных входов и выходов драйверов нескольких каналов для увеличения тока в первичной обмотке трансформатора.

Ниже на рис. 5-4...рис. 5-7 (стр. 5-5) в качестве дополнительной иллюстрации работы микросхемы приведены осциллограммы некоторых сигналов.

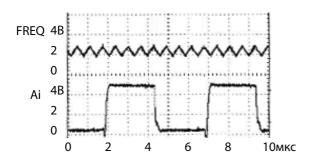


Рис. 5-4. Осциллограммы напряжений на выводах FREQ и Ai

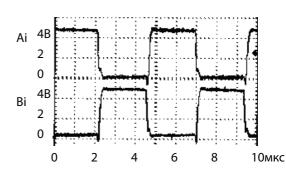
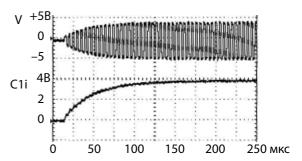


Рис. 5-5. Осциллограммы напряжений на выводах драйверов





Примечание к рисунку. Точку съема V см. рис. 5-2 (стр. 5-3).

Рис. 5-6. Осциллограмма напряжения на первичной обмотке (Ai – Bi)

Рис. 5-7. Осциллограммы напряжений на вторичной обмотке V и на C1i

5.3. Электрические параметры

5.3.1. Номинальные значения электрических параметров

Таблица 5-2. Номинальные значения электрических параметров

Наименование параметра, единица и условия		Норма параметра		Температура
измерения	Символ	не менее	не более	среды, °C
Выходное напряжение низкого уровня, В (при U_{CC} =4,5 В и I_{OL} =0,8 мА).	U _{OL}	_	0,4	+25 ±10 -60 +85
Выходное напряжение высокого уровня, В (при $U_{\rm CC}$ =4,5 В и $I_{\rm OH}$ =0,8 мА).	U _{OH}	4,0		+25 ±10 -60 +85
			0,15	+25 ±10
Ток потребления статический, мА (при U _{CC} =5,5 B).	I _{CC}	_	0,4	-60 +85
Ток потребления динамический, мА (при U _{CC} =5,5 B).	l _{occ}	_	1,5	+25 ±10 -60 +85
Ток потребления одного канала динамический, мА (при U _{CC} =5,5 B).	I _{C1}	_	0,8	+25 ±10 -60 +85
Pyonuoš tov vtouvu uvevoro u puloovoro vpopuoš AWA (ppu		_	0,3	+25 ±10
Входной ток утечки низкого и высокого уровней, мкА (при U_{CC} =5,5 B).	I _{ILL} , I _{ILH}	_	3,0	-60 +85
PLIVA FUANT TOV VTOUVA HARVOTO A PLIAGUATO VPOPULO P		_	0,3	+25 ±10
Выходной ток утечки низкого и высокого уровней в состоянии «выключено», мкА (при U _{CC} =5,5 B).	I _{OZL} , I _{OZH}	_	3,0	-60 +85
Входная емкость, пФ.	C _I	_	5	+25 ±10
Емкость входа/выхода, пФ.	C _{IO}	_	5	+25 ±10
Электростатический потенциал, В.	U _{ESD}	_	2000	+25 ±10 -60 +85

Примечание к таблице. Полный ток потребления в динамическом режиме при использовании N каналов вычисляется как: $I_{TC} = I_{OCC} + N * I_{C1}$

5.3.2. Предельные режимы эксплуатации

Таблица 5-3. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации

		Значения параметров			
Наименование параметра и единица измерения	Символ допу	допус	ельно тимый ким	предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U _{CC}	4,5	5,5	-0,2	7
Внешнее напряжение на отключенном выходе, В	U _{OZ}	0	U _{CC}	-0,4	U _{CC} +0,4
Входное напряжение низкого уровня, В	U _{IL}	0	0,8 ⁽¹⁾	-0,4	_
Входное напряжение высокого уровня, В	U _{IH}	U_{CC} -0,4 ⁽¹⁾	U _{CC}	1	U _{CC} +0,4
Выходной ток низкого уровня, мА	I _{OL}	_	4,0		8,0
Выходной ток высокого уровня, мА	I _{OH}	_	2,0	_	8,0

Примечания к таблице.

5.4. Стойкость к воздействию внешних факторов

5.4.1. Механические факторы

В табл. 5-4 (стр. 5-6) приведены характеристики стойкости к внешним механическим воздействиям.

Таблица 5-4. Стойкость к внешним механическим воздействиям

Dee - e ve ve-	Наименование параметра и единица	Значения параметров		
Воздействие	измерения	не менее	не более	
	Диапазон частот, Гц	1	5000	
Синусоидальные вибрации	Амплитуда ускорения, м/с² (g)	_	400 (40)	
Удары одиночного действия	Амплитуда пикового ударного ускорения, м/с ² (g)	_	15000 (1500)	
в любом направлении	Длительность действия ударного ускорения, мс	0,1	2,0	
Удары многократного	Амплитуда пикового ударного ускорения, м/с ² (g)	_	1500 (150)	
действия в любом направлении	Длительность действия ударного ускорения, мс	1	5	
Линейное ускорение	Амплитуда ускорения, м/с ² (g)		5000 (500)	
Акустический шум	Диапазон частот, Гц	50	10000	
	Уровень звукового давления, дБ		170	

5.4.2. Климатические факторы

В табл. 5-5 (стр. 5-6) приведены характеристики стойкости к внешним климатическим факторам.

Таблица 5-5. Стойкость к внешним климатическим факторам

Наимонования поромотра одинина и условия измерания	Значения параметров		
Наименование параметра, единица и условия измерения	не менее	не более	
Повышенное рабочее давление, атм.		3	
Повышенная рабочая температура среды, °С		+85	
Повышенная предельная температура среды, °С		+125	
Пониженная рабочая температура среды, °С	-60		
Пониженная предельная температура среды, °С	-60		
Изменение температуры среды в пределах, °С	-60	+125	
Повышенная относительная влажность, % (при температуре +35°C)		98	

^{1.} С учетом всех видов помех.

5.4.3. Специальные факторы и надежность

Микросхемы соответствуют следующим требованиям по воздействию специальных факторов:

- 1. Характеристики И1, С1, С2 по 2У; И2 по 2У с коэффициентом 5; И3 по 2У; С3 по 1У, К1 по 1У с коэффициентом 2, К3 по 1У с коэффициентом 0,5; И8-И11 по 1У в соответствии с ГОСТ В 20 39.404, И4, И5 К•9В, где К=0,075.
- 2. Максимальный уровень характеристики И2, при котором отсутствует потеря работоспособности 0,02•1У.

Подтверждение уровня бессбойной работы проводится по следующим критериям:

 $\rm U_{OL}$ не более 0,3* $\rm U_{CC}$, $\rm U_{OH}$ не менее 0,7* $\rm U_{CC}$, $\rm I_{CCP}$ не более 300 мА.

В табл. 5-6 приведены характеристики надежности

Таблица 5-6. Характеристики надежности

Harman and the same and the sam	Значения параметров		
Наименование параметра, единица и условия измерения	не менее	не более	
Минимальная наработка, час	100000	_	
Минимальная наработка в облегченных режимах, час (при U_{CC} =5B±10%; I_{OL} , I_{OH} < 50% от величин, указанных в табл. 5-3, стр. 5-6)	120000	_	
Минимальный срок сохраняемости, лет	25		

5.5. Прочие характеристики

На рис. 5-8 приведена зависимость частоты тактового генератора от емкости внешнего конденсатора, подключенного к выводу FREQ.

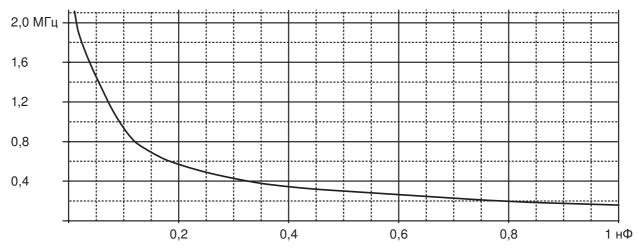


Рис. 5-8. Зависимость частоты на выводе FREQ от подключенной к нему емкости С

5.6. Корпус и рекомендации по монтажу

Микросхема 5503XM1-289 изготавливается в планарном керамическом корпусе типа H 09.28-1B (табл. 7-1, стр. 7-2).

Первый вывод обозначается равносторонним треугольником на крышке корпуса, а также и стрелкой на основании корпуса у корпусов с золотым покрытием. У корпусов с никелевым покрытием стрелкой на основании корпуса обозначается 28 вывод.

Корпус имеет два технологических вывода, которые не используются при эксплуатации микросхемы и не должны подключаться. Чертеж приведен на рис. 7-14 (стр. 7-16).

Рекомендуемый вариант установки микросхемы на печатную плату приведен на рис. 5-9 (стр. 5-8).